

增刊

硅微条探测器的辐射损伤试验

顾维新¹, R.Lipton²

((1 中国科学院高能物理研究所 北京 100039)

(2 Fermilab, Batavia, ILL60510, U.S.A.))

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 测量了硅微条探测器在辐照前后的坪曲线、脉冲高度与偏置电压的关系, 及辐照后的总漏电流和黑洞的大小.

关键词 [硅微条探测器](#) [辐射损伤](#) [黑洞](#) [耗尽电压](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

顾维新

作者个人主页: [顾维新¹; R.Lipton²](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(232KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\] \(OKB\)](#)

▶ [参考文献 \[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“硅微条探测器”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [顾维新](#)

• [RLipton](#)